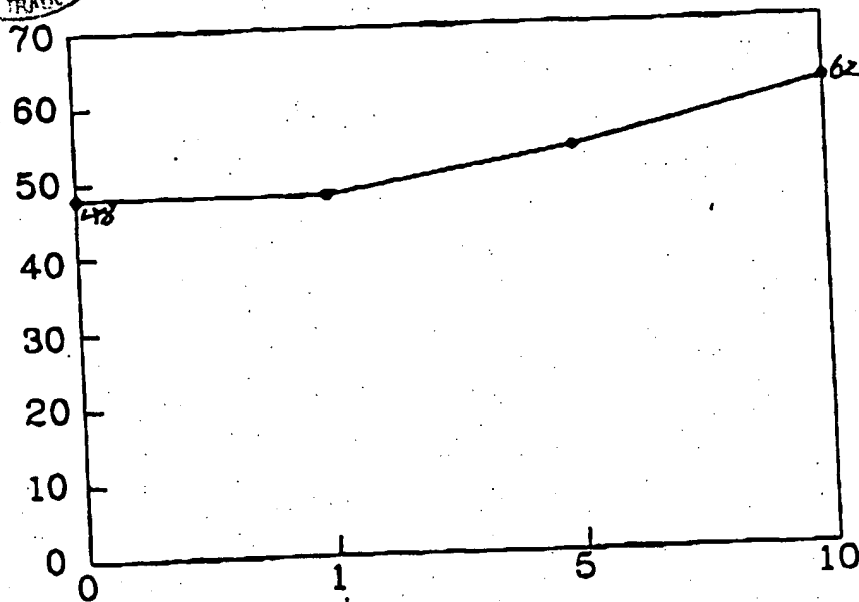


Implant energy = 35keV

thickness of gate oxide (Å)

氧化層厚度 (Å)



Faxed SF

佈值劑量 (1E14 CM⁻²)

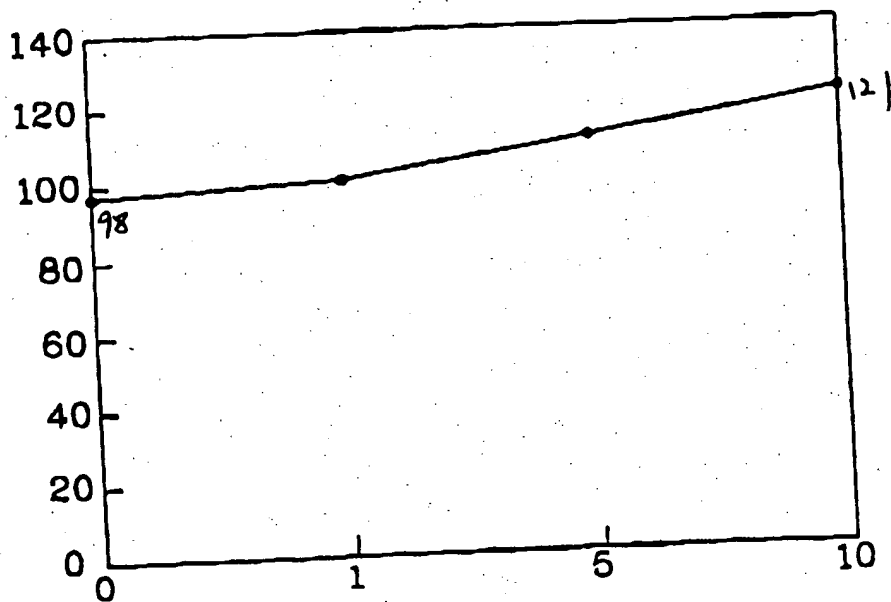
close

圖 三 A fig 3A.

Implant energy = 35keV

thickness of gate oxide (Å)

氧化層厚度 (Å)



佈值劑量 (1E14 CM⁻²)

close

圖 三 B fig 3B.